

2SD2211 / 2SD1918 / 2SD1857A

- 1) High breakdown voltage.($V_{CE0} = 160V$)
- 2) Low collector output capacitance.
(Typ. 20pF at $V_{CB} = 10V$)
- 3) High transition frequency.($f_T = 80MHz$)
- 4) Complements the 2SB1275 / 2SB1236A.

Parameter		Symbol	Limits	Unit
Collector-base voltage		V _{CB0}	160	V
Collector-emitter voltage		V _{CE0}	160	V
Emitter-base voltage		V _{EB0}	5	V
Collector current		I _C	1.5	A(DC)
			3	A(Pulse)
Collector power dissipation	2SD1857A	P _C	1	W
	2SD2211		2	W
	2SD1918		1	W
			10	W(T _C ≈25°C)
Junction temperature		T _J	150	°C
Storage temperature		T _{stg}	-55 ~ +150	°C

Type	2SD2211	2SD1918	2SD1857A
Package	MPT3	CPT3	ATV
hfe	QR	Q	PQ
Marking	DQ*	—	—
Code	T100	TL	TV2
Basic ordering unit (pieces)	1000	2500	2500

ROHM : MPT3
EIA1 : SC-62

(1) Base(Gate)
(2) Collector(Drain)
(3) Emitter(Source)

ROHM : CPT3
EIAJ : SC-63

(1) Base/Gate
(2) Collector/Drain
(3) Emitter/Source

[illegible]

Parameter		Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Collector-base breakdown voltage		BV_{CBO}	160	—	—	V	$I_C = 50\mu A$
Collector-emitter breakdown voltage		BV_{CEO}	160	—	—	V	$I_C = 1mA$
Emitter-base breakdown voltage		BV_{EBO}	5	—	—	V	$I_E = 50\mu A$
Collector cutoff current		I_{CBO}	—	—	1	μA	$V_{CB} = 120V$
Emitter cutoff current		I_{EBO}	—	—	1	μA	$V_{EB} = 4V$
Collector-emitter saturation voltage		$V_{CE(sat)}$	—	—	2	V	$I_C/I_B = 1A/0.1A$
Base-emitter saturation voltage		$V_{BE(sat)}$	—	—	1.5	V	$I_C/I_B = 1A/0.1A$
DC current transfer ratio	2SD2111, 2SD1918	h_{FE}	120	—	390	—	$V_{CE}/I_C = 5V/0.1A$
	2SD1857A		82	—	270	—	
Transition frequency		f_T	—	80	—	MHz	$V_{CE} = 5V, I_E = -0.1A, f = 30MHz$
Output capacitance		Cob	—	20	—	pF	$V_{CB} = 10V, I_E = 0A, f = 1MHz$

* Measured using pulse current.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9